

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Mai 2005 (06.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/041247 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001877

(22) Internationales Anmeldedatum:
24. August 2004 (24.08.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10345410.1 30. September 2003 (30.09.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH** [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HAAS, Heinz** [DE/DE]; Wassergasse 14, 93059 Regensburg (DE). **MÖLLMER, Frank** [DE/DE]; Am Mühlgraben 4, 93080 Matting b. Pentling (DE). **SCHWIND, Michael** [DE/DE]; Heckenweg 12, 93161 Sinzing (DE).

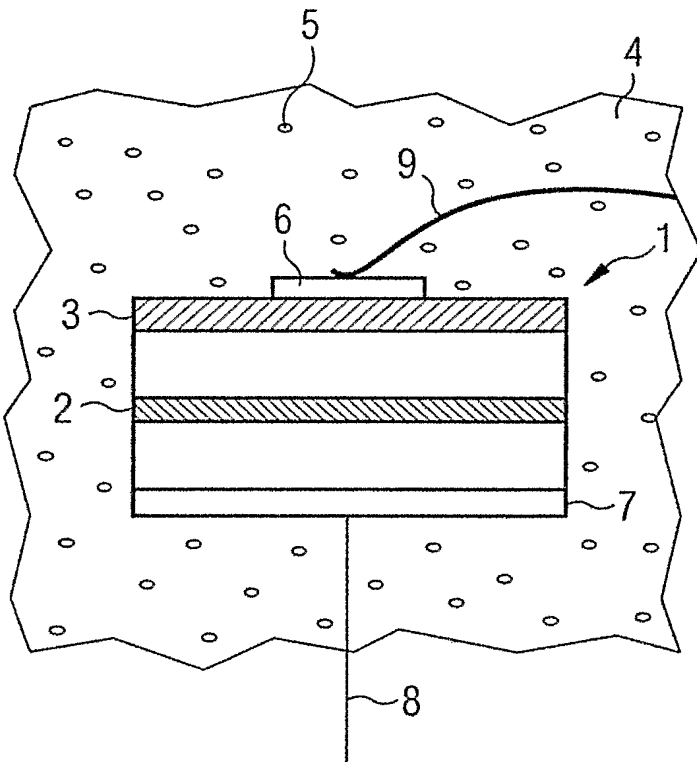
(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH**; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: RADIATION DETECTOR

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSDETEKTOR



(57) Abstract: The invention relates to a radiation detector for detecting radiation with a preset spectral sensitivity distribution (14), which has a maximum sensitivity in a predetermined wavelength λ_0 , wherein the radiation detector preferably contains a III-V semiconductor material and more preferably comprises at least one semiconductor chip (1) and at least one optical filter arranged downstream of the semiconductor chip. The semiconductor chip contains at least one III-V semiconductor material and the filter absorbs radiation with a wavelength that is bigger than wavelength λ_0 of the maximum sensitivity.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Strahlungsdetektor zur Detektion von Strahlung mit einer vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung (14), die ein Empfindlichkeitsmaximum bei einer vorgegebenen Wellenlänge λ_0 aufweist wobei der Strahlungsdetektor bevorzugt ein III-V-Halbleitermaterial enthält und besonders bevorzugt mindestens einen Halbleiterchip (1) und mindestens einen dem Halbleiterchip nachgeordneten optischen Filter umfasst, wobei der Halbleiterchip mindestens ein III-V-Halbleitermaterial enthält und der optische Filter Strahlung mit einer Wellenlänge absorbiert, die größer als die Wellenlänge λ_0 des Empfindlichkeitsmaximums ist.

WO 2005/041247 A2



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Strahlungsdetektor

- 5 Die Erfindung betrifft einen Strahlungsdetektor nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beziehungsweise des Patentanspruchs 3.

Zur Detektion von Strahlung mit einer vorgegebenen spektralen
10 Empfindlichkeitsverteilung, die ein Maximum bei einer vorgegebenen Wellenlänge λ_0 aufweist, werden oftmals Strahlungsdetektoren mit einer speziell angepaßten Filteranordnung, wie beispielsweise Interferenzfiltern oder Monochromatoren verwendet. Derartige Detektoren zeichnen sich durch eine sehr
15 gute Anpassung an die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung aus, sind aber in ihrer Handhabung und Herstellung meist vergleichsweise aufwendig und kostenintensiv. Weiterhin haben sie oftmals einen hohen Platzbedarf, so dass sie für Anwendungen auf kleinem Raum nicht oder nur eingeschränkt be-
20 nutzt werden können.

Ist die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung die des menschlichen Auges, so wird zur Detektion einfallender Strahlung mit dieser Empfindlichkeit häufig eine Silizium-Photo-
25 diode benutzt.

Die Empfindlichkeit einer Photodiode hängt unter anderem von den Wellenlängen der einfallenden Strahlung ab. Für Wellenlängen, die größer als eine Grenzwellenlänge sind, ist die
30 Empfindlichkeit zumindest nahe null, da für einfallende Strahlung in diesem Wellenlängenbereich die Energielücke des Funktionsmaterials der Diode - beispielsweise Si - größer als die Energie der einfallenden Strahlung ist und diese somit

nicht für die Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren ausreicht. Andererseits nimmt die Empfindlichkeit im Bereich kleiner werdender Wellenlängen ab, da mit sinkender Wellenlänge die erzeugten Elektron-Loch-Paare beispielsweise wegen der Oberflächenrekombination vermehrt nicht mehr zum Photostrom beitragen. Im Zwischenbereich weist die Empfindlichkeit der Diode ein Maximum auf, das bei einer Silizium-Photodiode bei ungefähr 800 nm liegt.

Die Verwendung einer derartigen Silizium-Photodiode als Detektor mit der spektralen Empfindlichkeitsverteilung des helladaptierten menschlichen Auges, das ein Maximum der Empfindlichkeit bei etwa 555 nm aufweist, erfordert zusätzlichen Aufwand, da die Wellenlängen der Empfindlichkeitsmaxima stark voneinander abweichen und die beiden spektralen Empfindlichkeitsverteilungen deshalb vergleichsweise schlecht aneinander angepasst sind. Die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die Empfindlichkeitsverteilung des menschlichen Auges kann durch mehrere komplexe Filter verbessert werden. In der Summe resultiert daraus die Empfindlichkeit des menschlichen Auges.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Strahlungsdetektor der eingangs genannten Art anzugeben, der möglichst einfach und kostengünstig herstellbar ist sowie eine gute Anpassung an die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung, insbesondere die des menschlichen Auges, aufweist.

Für eine gute Anpassung ist es als im Rahmen der Erfindung ausreichend anzusehen, dass die Detektorempfindlichkeit weitgehend der vorgegebenen Empfindlichkeit entspricht. Eine vollständige Übereinstimmung der Empfindlichkeiten ist nicht zwingend notwendig. Es soll vielmehr eine möglichst gute An-

passung an die vorgegebene Empfindlichkeit mit einem möglichst geringen Aufwand erreicht werden.

5 Diese Aufgabe wird durch einen Strahlungsdetektor mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 beziehungsweise des Patentanspruchs 3 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

10 Ein Strahlungsdetektor zur Detektion von Strahlung gemäß einer vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung, die ein Empfindlichkeitsmaximum bei einer vorgegebenen Wellenlänge λ_0 aufweist, umfasst gemäß der vorliegenden Erfindung mindestens einen Halbleiterchip, welcher ein III-V-Halbleitermaterial enthält.

15 Mit Vorzug ist der Halbleiterchip bei der Erfindung ein LED-Chip, der als Strahlungsemitter zur Anwendung in einer herkömmlichen LED vorgesehen ist. Dies ermöglicht eine kostengünstige Verwirklichung des Strahlungsdetektors, da für eine
20 Funktion als Strahlungsemitter vorgesehene LED-Chips als Halbleiterchips des Strahlungsdetektors verwendet werden können und der Aufwand zur Herstellung gezielt auf einen Strahlungsdetektor abgestimmter Halbleiterchips vermieden werden kann.

25 Das III-V-Halbleitermaterial umfasst bevorzugt das Funktionsmaterial des Halbleiterchips, insbesondere des LED-Chips, und/oder ist so gewählt, dass die Empfindlichkeit des Halbleiterchips in dem Bereich der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung von null verschieden ist. Die Empfindlichkeit des Chips wird dabei durch die Stärke des Photostroms bestimmt, der von einer auf den Halbleiterchip einfallenden Strahlung durch Generation von Elektron-Loch-Paaren im
30

Funktionsmaterial entsteht. Die Stromstärke des Photostroms ist von der einfallenden Strahlungsleistung und der Wellenlänge der einfallenden Strahlung abhängig und liegt typischerweise in der Größenordnung von nA. Deshalb durchläuft
5 der Photostrom bevorzugt zum Zwecke besserer Signalverarbeitung oder -detektion einen Operationsverstärker.

Besonders bevorzugt besitzt der Halbleiterchip, insbesondere der LED-Chip, ein Maximum der Empfindlichkeit bei einer Wellenlänge λ_1 , die sich möglichst wenig von der vorgegebenen Wellenlänge λ_0 unterscheidet. Die Wellenlänge λ_0 liegt vorteilhafterweise im Bereich der Emissionswellenlänge - beispielsweise der Peak- oder der Dominantwellenlänge - des LED-Chips, die dieser bei einem Betrieb als Strahlungsemitter
15 aussenden würde.

Es sei allerdings angemerkt, dass die Wellenlänge λ_1 nicht notwendigerweise einem Maximum der Empfindlichkeit des Halbleiterchips, insbesondere des LED-Chips, entsprechen muß. Es
20 kann vielmehr genügen, dass sie bei λ_1 einen ausreichend hohen Wert annimmt, wenn beispielsweise kein geeignetes Halbleitermaterial mit einem Empfindlichkeitsmaximum bei λ_1 , das im obigen Sinne nahe genug bei λ_0 liegt, vorhanden ist.

Bevorzugt ist die Differenz der Wellenlängen λ_0 und λ_1 dem Betrag nach kleiner als 50 nm, besonders bevorzugt kleiner als 15 nm. Der Strahlungsdetektor kann somit bereits durch eine geeignete Auswahl des LED-Chips beziehungsweise des III-V-Halbleitermaterials an die vorgegebene Empfindlichkeit voran-
30 gepasst werden.

Die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung wird häufig so angegeben, dass sie bei der Wellenlänge λ_0 den Wert

1 beziehungsweise 100% annimmt. Die Empfindlichkeit des Halbleiterchips, insbesondere des LED-Chips, die vom Photostrom abhängt, wird häufig in Ampere pro Watt der einfallenden Strahlungsleistung angegeben.

5

Zum Vergleich der Detektorempfindlichkeit mit der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung ist es deshalb zweckmäßig, die beiden Empfindlichkeiten so aneinander anzupassen, dass die vorgegebene Empfindlichkeit bei λ_0 und die
10 Empfindlichkeit des Detektors bei λ_1 jeweils den Wert 100% annehmen (relative Empfindlichkeiten). Die vorliegende Beschreibung bezieht sich auf relative Empfindlichkeiten, sofern nichts anderes angegeben ist.

15 Bei der Erfindung ist es vorgesehen, dass zur Voranpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung LED-Chips eingesetzt werden können, wie sie in handelsüblichen LEDs verwendet werden, die ein III-V-Halbleitermaterial als Funktionsmaterial besitzen. Der
20 Aufwand und die damit verbundenen Kosten, die eine spezielle Herstellung eines neuen Halbleiterchips für einen Detektor mit sich bringt werden dadurch vorteilhaft vermieden.

Abhängig von der Wellenlänge λ_0 können beispielsweise Halbleiterchips, insbesondere LED-Chips, herangezogen werden, die
25 $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{P}$, $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{N}$ oder $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{As}$, jeweils mit $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ und $x+y \leq 1$, als III-V-Halbleitermaterial enthalten. III-V-Halbleitermaterialien zeichnen sich durch eine vereinfacht erreichbare vorteilhaft hohe interne Quanteneffizienz aus. Insbesondere gilt dies im sichtbaren Spektralbereich, in dem die Wellenlänge λ_0 bevorzugt liegt. Für diesen Spektralbereich sind insbesondere Halbleitermaterialien aus
30

den Materialsystemen $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{P}$ oder $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{N}$ besonders geeignet.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist dem
5 Halbleiterchip, insbesondere dem LED-Chip, mindestens ein optischer Filter nachgeordnet, der die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene Empfindlichkeitsverteilung verbessert. Dies geschieht beispielsweise durch Absorption von Wellenlängen aus der einfallenden Strahlung, für die die
10 Empfindlichkeit des Halbleiterchips, insbesondere des LED-Chips, höher als die der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung ist.

Ein derartiger Filter absorbiert bevorzugt Wellenlängen, die
15 größer als λ_0 sind, und kann zumindest teilweise innerhalb, außerhalb und/oder auf einer den Halbleiterchip, insbesondere den LED-Chip, zumindest teilweise umgebenden Umhüllung angeordnet sein. Weiterhin kann auch das Umhüllungsmaterial selbst den optischen Filter bilden oder Teil dieses Filters
20 sein.

Der optische Filter umfasst bevorzugt eine Mehrzahl von Filterpartikeln, die besonders bevorzugt in der Umhüllung angeordnet sind und beispielsweise organische Farbstoffe enthalten.
25

Auch kann der optische Filter, beispielsweise in Form einer Filterfolie oder eines Filtermaterials auf der Umhüllung und/oder einer Filterstruktur außerhalb der Umhüllung vorge-
30 sehen sein.

Beispiele für Umhüllungsmaterialien sind Reaktionsharze, bevorzugt Acryl- Epoxid- oder Silikonharze oder eine Mischung aus diesen Materialien.

5 Derartige Materialien werden in der Halbleitertechnik oftmals zur Umhüllung Halbleiterchips, insbesondere von LED-Chips, benutzt. Bei LEDs, die als herkömmliche Strahlungsemitter ausgebildet sind, ist das Umhüllungsmaterial der LED-Chips für die emittierte Strahlung weitgehend durchlässig. Im Rahmen der Erfindung jedoch kann ein Strahlungsdetektor eine
10 Filteranordnung der oben genannten Art umfassen, die gerade Wellenlängen absorbiert, die vom LED-Chip in der Funktion als Strahlungsemitter erzeugt würden.

15 In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung enthält der Halbleiterchip, insbesondere der LED-Chip, mindestens eine Filterschicht. Diese Filterschicht ist bevorzugt auf der Oberfläche, insbesondere einer strahlungseintrittseitigen Oberfläche, des Chips angeordnet. Mit Vorteil absorbiert die
20 Filterschicht Wellenlängen die kleiner sind als die Wellenlänge λ_0 der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung, wodurch die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung, insbesondere auf der kurzwelligen Seite, weitergehend verbessert
25 wird.

Vorzugsweise ist die Filterschicht in der Form einer Passivierungs-, Deck- und/oder Schutzschicht ausgeführt, wie sie zum Beispiel bereits in handelsüblichen LED-Chips enthalten
30 oder integriert ist. Die Filterschicht ist dabei so ausgeführt, dass einfallende Strahlung mit einer Wellenlänge die kleiner als λ_0 ist derart absorbiert wird, dass die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene spektrale Emp-

findlichkeitsverteilung weiter verbessert wird. Derartige Schichten weisen in der Regel eine Energielücke auf, die größer als die Energielücke der aktiven Zone des LED-Chips ist. Diese Schichten sind für die von der LED erzeugten Strahlung weitgehend durchlässig und schützen das Funktionsmaterial beispielsweise vor nachteiligen äußeren Einflüssen.

Gegebenenfalls kann die Filterschicht monolithisch im Halbleiterchip, insbesondere im LED-Chip, integriert sein, indem die Filterschicht, beispielsweise epitaktisch auf einem Aufwachssubstrat, zusammen mit einem Halbleiterkörper für den Halbleiterchip hergestellt wird.

Die Detektorempfindlichkeit ist dabei durch die Filterschicht bevorzugt so beeinflusst, dass bei einer beliebigen Wellenlänge kleiner als λ_0 die Differenz der Detektorempfindlichkeit und der vorgegebenen Empfindlichkeit kleiner als 25%, besonders bevorzugt kleiner als 15% ist.

Mit besonderem Vorteil muss die Detektorempfindlichkeit für Wellenlängen kleiner als λ_0 nicht mehr zusätzlich durch optische Filter, die außerhalb des Halbleiterchips, insbesondere LED-Chips, angeordnet sind, an die vorgegebene Empfindlichkeit angepasst werden. Die Anpassung kann vielmehr durch die im Halbleiterchip, insbesondere LED-Chip, enthaltene Filterschicht geschehen.

Die Filterung für Wellenlängen kleiner als λ_0 kann auch durch einen optischen Filter der oben genannten Art erreicht werden, der außerhalb des Halbleiterchips, insbesondere LED-Chips, beispielsweise in der Umhüllung angeordnet ist. Ist eine Filterschicht der oben genannten Art aber bereits im Halbleiterchip, insbesondere im LED-Chip, vorgesehen, werden

der Herstellungsaufwand und die Herstellungskosten des Strahlungsdetektors vorteilhaft verringert.

In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist bei einer beliebigen Wellenlänge die Differenz der Detektorempfindlichkeit und der vorgegebenen Empfindlichkeit kleiner als 40%, bevorzugt kleiner als 25%. Besonders vorteilhaft ist dafür die Kombination einer Filterschicht auf dem LED-Chip oder in diesem integriert mit einem nachgeordneten optischen Filter, der oben genannten Art. Derartige Detektoren weisen verglichen mit anderen Detektoren einen geringen Platzbedarf und eine gute Anpassung an die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung auf.

Besonders bevorzugt ist bei einer, insbesondere beliebigen, Wellenlänge in einem Spektralbereich, der das Maximum λ_0 der vorgegebenen Empfindlichkeit enthält die Differenz der Detektorempfindlichkeit und der vorgegebenen Empfindlichkeit kleiner als 15%.

Zur Anpassung der Empfindlichkeiten kann folgendermaßen vorgegangen werden. Der LED-Chip wird zuerst so ausgewählt, dass seine Empfindlichkeit gut an die vorgegebene Empfindlichkeit vorangepasst ist.

Diese Voranpassung kann entweder bezüglich der Flanken - den Wellenlängenbereichen größer oder kleiner λ_0 - der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung oder deren Maximum, beispielsweise durch die Auswahl eines geeigneten LED-Chips, geschehen.

Zur weiteren Anpassung dienen die Filter - dem LED-Chip nachgeordnete optische Filter oder Filterschichten -, die insbe-

sondere in dem Wellenlängenbereich absorbieren, in denen der LED-Chip eine höhere Empfindlichkeit als die vorgegebene Empfindlichkeitsverteilung besitzt.

5 Da LED-Chips häufig im Bereich ihrer Emissionswellenlänge die höchste Empfindlichkeit aufweisen, sei angemerkt, dass solche Filter bei einer herkömmlichen LED als Strahlungsemitter die Strahlungsausbeute verringern würden. Dies gilt insbesondere für optische Filter die in der Umhüllung des LED-Chips ange-
10 ordnet sind. Eine derartige Umhüllung ist somit nicht mit der Umhüllung eines herkömmlichen LED-Chips als Strahlungsemitter vergleichbar.

Bevorzugt ist die Differenz der Werte der Detektorempfind-
15 lichkeit und der vorgegebenen Empfindlichkeit bei einer vorgegebenen Wellenlänge für Empfindlichkeitswerte größer als 50 % kleiner als 25%, besonders bevorzugt kleiner als 15%.

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
20 ist die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung die des menschlichen Auges mit einem Maximum bei der Wellenlänge λ_0' . Diese Wellenlänge liegt gewöhnlich für ein helladaptiertes Auge (Tagsehen) bei ungefähr 555 nm und für ein dunkeladaptiertes Auge (Nachtsehen) bei ungefähr 500 nm.

25

LED-Chips mit einer Emissionswellenlänge im sichtbaren, insbesondere im roten, Spektralbereich sind für diese vorgegebene Empfindlichkeit besonders geeignet, da sie trotz ihrer roten Emissionswellenlänge eine hohe Empfindlichkeit bei den
30 oben genannten Wellenlängen aufweisen können. Ein für die Empfindlichkeitsverteilung des helladaptierten Auges vorteilhaftes Halbleitermaterial ist $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{P}$, da ein auf diesem Material basierender LED-Chip je nach der genauen Zusammen-

setzung ein Maximum der Empfindlichkeit aufweisen kann, das im Bereich der oben angeführten Wellenlänge liegt. Durch optische Filter und Filterschichten der oben genannten Art, kann die Detektorempfindlichkeit weiter an die Augenempfind-
5 lichkeit angepasst werden.

Weiterhin kann der Strahlungsdetektor als oberflächenmontierbares Bauelement ausgebildet sein.

10 Erfindungsgemäße Strahlungsdetektoren werden vorzugsweise zur Steuerung und/oder Einflussnahme auf Vorrichtungen, deren Funktionsweise, Funktionszeitraum Wahrnehmung und/oder Anwendung mit der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung in Verbindung steht verwendet.

15

Beispiele hierfür sind die Steuerung der Helligkeiten von Beleuchtungseinrichtung und Anzeigen, sowie des Ein- und/oder Ausschaltzeitpunkts von Beleuchtungseinrichtungen. Solche Beleuchtungseinrichtungen können als Innen- und Aussenraumbeleuchtungen für Wohnungen, Straßen oder Autos sowie die Hinterleuchtungseinrichtungen von Displays, wie Handydisplays, Autodisplays oder LCD-Bildschirmen realisiert sein. Für die
20 letztgenannten Anwendungen ist ein geringer Platzbedarf des Strahlungsdetektors von besonderem Interesse.

25

Bei den genannten Verwendungen der Erfindung ist die vorgegebene Empfindlichkeit bevorzugt die des menschlichen Auges gegeben. Somit werden etwa die Helligkeiten der genannten Beleuchtungseinrichtungen können damit - durch Erhöhung oder
30 Erniedrigung der Helligkeit - vorteilhaft entsprechend der Wahrnehmung durch das menschliche Auge gesteuert.

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Verwendung eines derartigen Strahlungsdetektors als Umgebungslichtsensor. Die vorgegebene Empfindlichkeit ist auch hier mit Vorzug durch die des menschlichen Auges gegeben.

5

Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus den Beschreibungen der folgenden Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den folgenden Figuren.

10 Es zeigen

Figur 1a und Figur 1b eine schematische Schnittansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strahlungsdetektors sowie eine schematische
15 Schnittansicht eines Teiles eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strahlungsdetektors;

Figur 2 schematisch die spektrale Verteilung der Detektor-empfindlichkeiten eines dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strahlungsdetektors mit verschiedenen optischen Filtern und die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung des menschlichen helladaptierten Auges, die bezüglich
20 der Empfindlichkeitswerte auf die Empfindlichkeit
25 des Chips bezogen ist;

Gleichartige und gleich wirkende Elemente besitzen in den Figuren gleiche Bezugszeichen.

30

In der Figur 1a ist eine schematische Schnittansicht eines LED-Chips 1 dargestellt, wie er in einem erfindungsgemäßen Strahlungsdetektor verwendet werden kann. Der Chip 1 weist

eine Schicht aus einem Funktionsmaterial 2 auf, die beispielsweise das III-V-Halbleitermaterial InGaAlP enthält und von Confinementschichten begrenzt wird. Derartiges Halbleitermaterial zeichnet sich durch eine hohe Quanteneffizienz aus und wird häufig in Leuchtdioden, wie beispielsweise der Diode mit der Typenbezeichnung F 1998 A (Hersteller Osram Opto Semiconductors GmbH), benutzt. Diese LED hat eine Emissionswellenlänge im roten Spektralbereich von ungefähr 630 nm.

Der Funktionsschicht 2 ist eine Filterschicht 3 nachgeordnet, die einfallende Strahlung mit Wellenlängen, die kleiner sind als die der Energielücke der Funktionsschicht 2 entsprechenden Wellenlänge, absorbiert. Diese Filterschicht ist bei dem LED-Chip, wie er in der F 1998 A verwendet wird, bereits vorgesehen und hat in der dortigen LED in der Funktion als Strahlungsemitter beispielsweise die Funktion einer Schutz- und/oder Deckschicht, die schädlichen äußeren Einflüssen auf den LED-Chip vorbeugen kann.

Figur 1b zeigt eine schematische Schnittansicht eines Teiles eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Strahlungsdetektors. Der LED-Chip 1 aus Figur 1a ist in einer Umhüllung 4 angeordnet, die ein Reaktionsharz enthält. Dieses Reaktionsharz ist bevorzugt mit organischen Farbstoffpartikeln 5 versehen, die spektrale Teilbereiche der einfallenden Strahlung absorbieren können und somit als optischer Filter wirken. Weiterhin ist der LED-Chip mit einem Bondpad 6 und einer Elektrode 7 zur elektrischen Kontaktierung des LED-Chips versehen. Über den mit der Elektrode 7 verbundenen externen elektrischen Anschluss 8 und einen mit dem Bonddraht 9 verbundenen weiteren externen Anschluss, der in der Figur 1b nicht dargestellt ist, kann ein von einer einfallenden Strahlung in der Funktionsschicht erzeugter Photostrom, eventuell

über einen Operationsverstärker, gemessen werden. Die Abhängigkeit des Photostroms von der einfallenden Strahlungsleistung und der Wellenlänge der Strahlung bestimmt die Empfindlichkeit eines Strahlungsdetektors, der eine derartige Struktur mit dem LED-Chip 1, der die Filterschicht 3 aufweist, und der Umhüllung 4, in der die Farbstoffpartikel 5 angeordnet sind, umfasst.

Ein derartiger Strahlungsdetektor kann kostengünstig hergestellt werden, da LED-Chips Verwendung finden, wie sie in herkömmlichen als Strahlungsemitter ausgebildeten LEDs benutzt werden. Unterschiede zwischen diesen Detektoren und LEDs bestehen in der Beschaffenheit des Umhüllungsmaterials. Während bei LEDs das Umhüllungsmaterial für die erzeugte Strahlung durchlässig ist, kann es im Falle des Strahlungsdetektors mit dem LED-Chip erwünscht sein, dass die Umhüllung 4 mit den Filterpartikeln 5 gerade Wellenlängen aus dem Bereich, in dem der LED-Chip emittieren würde, absorbiert, um die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene Empfindlichkeit vorteilhaft zu verbessern.

Aus Figur 2 wird deutlich, wie die Detektorempfindlichkeit durch optische Filterung, beispielsweise in der Umhüllung des LED-Chips, an die spektrale Empfindlichkeitsverteilung des menschlichen Auges angepasst wird.

In der Figur 2 sind schematisch die spektralen Verteilungen der relativen Detektorempfindlichkeiten 10, 11 und 12 erfindungsgemäßer Strahlungsdetektoren mit verschiedenen optischen Filtern und die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung 14 des menschlichen helladaptierten Auges in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ der einfallenden Strahlung dargestellt. Die Empfindlichkeit S ist dabei in Prozent angegeben.

Die Strahlungsdetektoren enthalten jeweils einen LED-Chip, wie er beispielsweise in der LED F 1998 A (Hersteller Osram Opto Semiconductors GmbH), verwendet wird. Der LED-Chip hat
5 eine Emissionswellenlänge im roten Spektralbereich von ungefähr 630 nm und enthält InGaAlP als Funktionsmaterial. Die dargestellten relativen Empfindlichkeitsverteilungen 10, 11 und 12 der Detektoren sind für einen Lichteinfall von der Seite der Filterschicht 3 her angegeben, die, wie in Figur 1a
10 oder 1b dargestellt, der Funktionsschicht 2 des LED-Chips 1 nachgeordnet ist. Alle Kurvenverläufe 10, 11 und 12 der Detektorempfindlichkeiten weisen ein Empfindlichkeitsmaximum 13 bei $\lambda_1 \approx 560$ nm auf. Die diesen Kurven entsprechenden Detektoren unterscheiden sich in den dem LED-Chip 1 nachgeordneten
15 optische Filteranordnungen. Der der Empfindlichkeitsverteilung 10 entsprechende Detektor ist ohne eine dem LED-Chip 1 nachgeordnete Filteranordnung ausgeführt, während bei den Verteilungen 11 und 12 eine 1 mm beziehungsweise 2 mm dicke filternde Umhüllung um den LED-Chip vorgesehen ist. Die filternde Umhüllung ist beispielsweise wie in Figur 1b ein Reak-
20 tionsharz, das zum Beispiel grüne organische Farbstoffe aufweist.

Die relative spektrale Empfindlichkeitsverteilung eines hell-
25 adaptierten menschlichen Auges ist bei $\lambda_0 \approx 555$ nm maximal und in der Figur 2 durch eine gepunktete Kurve 14 dargestellt. Im Zweifel kann im Rahmen der Erfindung die Augenempfindlichkeitsverteilung nach der entsprechenden DIN herangezogen werden.

30

Weiterhin sind in der Figur 2 Wellenlängen λ_a , λ_b , λ_c , λ_d und λ_e dargestellt, die verschiedene Bereiche der gezeigten Empfindlichkeitsverteilungen kennzeichnen.

Im Wellenlängenbereich zwischen ungefähr λ_a und λ_1 stimmen die Empfindlichkeiten 10, 11 und 12 schon gut mit der Augenempfindlichkeit 14 überein, was durch die Filterschicht 3 erreicht wird, die einfallende Strahlung in diesem Wellenlängenbereich absorbieren kann und dadurch die Anpassung der Detektorempfindlichkeit 10, 11, 12 an die Augenempfindlichkeit 14 vorteilhaft beeinflusst.

Die Detektor- und die Augenempfindlichkeit weichen bezüglich ihrer Wellenlängen bei einem gemeinsamen Wert der Empfindlichkeit in diesem Wellenlängenbereich bevorzugt um weniger als 30 nm besonders bevorzugt weniger als 15 nm voneinander ab.

Weiterhin ist die Differenz der Empfindlichkeitswerte der Augen- und der Detektorempfindlichkeit bei einer vorgegebenen Wellenlänge in diesem Bereich kleiner als 15%.

Für $\lambda < \lambda_a$ allerdings fallen die Detektorempfindlichkeiten 10, 11, 12 im Gegensatz zur Augenempfindlichkeit 14 deutlich stärker ab und sind bereits für Wellenlängen kleiner als ungefähr λ_b zumindest nahe null. Eine Ursache dafür kann die Oberflächenrekombination von Elektron-Loch-Paaren sein, da diese Paare nicht mehr zum Photostrom beitragen können. Auch für Wellenlängen größer als ungefähr λ_c fallen die Detektorempfindlichkeiten stärker als die Augenempfindlichkeit ab, da die Energie der einfallenden Strahlung für Wellenlängen größer als λ_c nicht mehr für die Generation von Elektron-Loch-Paaren ausreicht.

Die Kurve 10 zeigt neben dem Empfindlichkeitsmaximum 13 noch weitere lokale Maxima 151 und 161. Diese liegen im Bereich um

die Emissionswellenlänge des LED-Chips, die bei ungefähr 630 nm liegt. Wie der Kurve 10 zu entnehmen ist, weicht die Detektorempfindlichkeit für $\lambda > \lambda_0$ in ihrem gesamten Verlauf noch relativ stark – die maximale Differenz der Empfindlichkeitswerte beträgt ungefähr 70% – von der Augenempfindlichkeit ab.

Für manche Anwendungen eines derartigen Strahlungsdetektors, insbesondere für Anwendungen die auf Wellenlängen kleiner als λ_0 abzielen, kann diese Anpassung an die Augenempfindlichkeit bereits ausreichend sein. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Detektor für Anwendungen auf kleinem Raum vorgesehen ist und eine relativ dicke filternde Umhüllung die Bauteilgröße nachteilig erhöht.

15

Eine derartige Anpassung kann, wie oben ausgeführt, bereits durch die geeignete Auswahl des Halbleitermaterials, beziehungsweise des LED-Chips, erreicht werden.

Um die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die Augenempfindlichkeit zu verbessern, ist bei den den Kurven 11 und 12 entsprechenden Detektoren eine Umhüllung vorgesehen, die aus der einfallenden Strahlung Wellenlängen größer als 555 nm – insbesondere im roten Spektralbereich des lokalen Maximums 151 bei ungefähr 630 nm – absorbiert.

25

Die Dicke der Umhüllung bestimmt die in ihr absorbierte Strahlungsleistung der einfallenden Strahlung und damit den erzeugten Photostrom und die Detektorempfindlichkeit.

30

Verglichen mit der Detektorempfindlichkeit 10 wird die Anpassung an die Augenempfindlichkeit 14 durch eine 1 mm dicke grüne Umhüllung wie der dargestellten Detektorempfindlichkeit

11 entnommen werden kann, weiter deutlich verbessert. Das lokale Maximum 151 der Kurve 10 entspricht der Schulter 152 in der Kurve 11 und ist durch die Absorption in der Umhüllung stark abgeflacht. Das lokale Maximum 161 ist in Form des Maximums 162, das wegen der Absorption in der Umhüllung einen geringeren Empfindlichkeitswert als das lokale Maximum 161 besitzt, noch vorhanden.

Wird eine 2 mm dicke grüne Umhüllung vorgesehen, ist die Anpassung der entsprechenden Detektorempfindlichkeit 12 an die Augenempfindlichkeit 14 wegen der höheren absorbierten Strahlungsleistung noch weiter verbessert. Auch hier bleibt das lokale Maximum 162 in Form des Maximums 163 erhalten. Das ursprüngliche Maximum 151 ist bei 153 so stark abgeflacht, dass es nicht mehr erkennbar ist.

Bei einer vorgegebenen Wellenlänge ist hierbei die Differenz der entsprechenden Detektor- und Augenempfindlichkeitswerte kleiner als 25%.

Für Werte der Empfindlichkeit S - größer als ungefähr 50% - ist der Detektor sehr gut an die Augenempfindlichkeit angepasst und die Differenz der Detektor- und der Augenempfindlichkeitswerte kleiner als ungefähr 10%. Eine derartige Anpassung an die Augenempfindlichkeit kann für Anwendungen ausreichend sein, da dies gerade der Bereich ist, in dem das Auge am empfindlichsten ist.

Zwischen ungefähr λ_e und λ_c weicht die Detektorempfindlichkeit 12 noch relativ stark von der Augenempfindlichkeit 14 ab. Würde im Strahlungsdetektor eine weitere Filteranordnung vorgesehen, die im Bereich der dem lokalen Maximum 163, 162 oder 161 entsprechenden Wellenlänge absorbiert, kann die An-

passung an die Augenempfindlichkeit 13 in diesem Bereich gegebenenfalls noch weiter verbessert werden.

Die Erfindung ist nicht als auf die Augenempfindlichkeit beschränkt, sondern auf alle vorgegebenen spektralen Empfindlichkeiten anwendbar anzusehen, die ein Maximum bei einer Wellenlänge λ_0 aufweisen, und an die die Empfindlichkeit eines Strahlungsdetektors, welcher einen LED-Chip enthält angepasst werden kann. Sollte die Empfindlichkeit des LED-Chips in manchen Wellenlängenbereichen kleiner als die vorgegebene Empfindlichkeit sein, so können insbesondere auch optische Verstärkeranordnungen vorgesehen sein, die sich vorteilhaft auf die Anpassung der Detektorempfindlichkeit an die vorgegebene Empfindlichkeit auswirken.

15

Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 103 45 410.1, deren gesamter Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug explizit in die vorliegende Patentanmeldung aufgenommen wird.

20

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Patentansprüche

1. Strahlungsdetektor zur Detektion von Strahlung gemäß einer vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung (14), die
5 ein Empfindlichkeitsmaximum bei einer vorgegebenen Wellenlänge λ_0 aufweist, wobei der Strahlungsdetektor mindestens einen Halbleiterchip (1) und mindestens einen dem Halbleiterchip (1) nachgeordneten optischen Filter umfasst,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
10 - der Halbleiterchip mindestens ein III-V-Halbleitermaterial enthält;
- der optische Filter Strahlung mit einer Wellenlänge absorbiert, die größer als die Wellenlänge λ_0 des Empfindlichkeitsmaximums ist.
- 15 2. Strahlungsdetektor nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die vorgegebene spektrale Empfindlichkeitsverteilung (14) die des menschlichen Auges ist.
- 20 3. Strahlungsdetektor, der mindestens einen Halbleiterchip (1) umfasst, zur Detektion von Strahlung gemäß der spektralen Empfindlichkeitsverteilung (14) des menschlichen Auges,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
25 der Halbleiterchip (1) mindestens ein III-V-Halbleitermaterial enthält.
4. Strahlungsdetektor nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
30 der Strahlungsdetektor mindestens einen dem Halbleiterchip (1) nachgeordneten optischen Filter umfasst und der optische Filter Strahlung mit einer Wellenlänge absorbiert die größer

als die Wellenlänge λ_0' des Empfindlichkeitsmaximums des menschlichen Auges ist.

5. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
der Halbleiterchip ein LED-Chip ist.

6. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Empfindlichkeit des Halbleiterchips (1) mindestens ein Maximum (13) bei einer Wellenlänge λ_1 aufweist, wobei sich diese Wellenlänge um nicht mehr als 50 nm, bevorzugt nicht mehr als 15 nm, von der Wellenlänge λ_0 beziehungsweise der Wellenlänge λ_0' abweicht.

7. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
der Detektor eine Umhüllung (4) aufweist, die den Halbleiterchip (1) zumindest teilweise umgibt.

8. Strahlungsdetektor nach Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Umhüllung (4) ein Harz, vorzugsweise ein Reaktionsharz, enthält.

9. Strahlungsdetektor nach Anspruch 7 oder 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
der optische Filter zumindest teilweise innerhalb, ausserhalb und/oder auf der Umhüllung (4) angeordnet ist und/oder das Umhüllungsmaterial selbst den Filter bildet.

10. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

5 der optische Filter eine Mehrzahl von Filterpartikeln (5) umfasst.

11. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

10 dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (1) eine Filterschicht (3) aufweist.

12. Strahlungsdetektor nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

15 die Filterschicht (3) Wellenlängen absorbiert, die kleiner als λ_0 beziehungsweise λ_0' sind.

13. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

20 dadurch gekennzeichnet, dass

der Strahlungsdetektor eine Detektorempfindlichkeit (12) aufweist, wobei bei einer beliebigen Wellenlänge die Differenz der entsprechenden Werte der Detektorempfindlichkeit (12) und der vorgegebenen Empfindlichkeit (14) kleiner als 40%, bevorzugt kleiner als 25%, ist.

14. Strahlungsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

30 das III-V-Halbleitermaterial $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{P}$, $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{N}$ oder $\text{In}_x\text{Ga}_y\text{Al}_{1-x-y}\text{As}$, jeweils mit $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ und $x+y \leq 1$, ist.

15. Strahlungsdetektor nach einem der Ansprüche 5 bis 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Emissionswellenlänge des LED-Chips (1) im roten Spektral-
bereich liegt.

5 16. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche
als
Umgebungslichtsensor.

10 17. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche
zur
Steuerung einer Einflussnahme auf Vorrichtungen, deren Funk-
tionsweise, Funktionszeitraum, Wahrnehmung und/oder Anwendung
15 mit der vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung in
Verbindung steht.

18. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche
20 zur
Steuerung der Helligkeit von Beleuchtungseinrichtungen.

19. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche
25 zur
Steuerung der Helligkeit der Hinterleuchtung von LCD-
Bildschirmen.

20. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vor-
30 hergehenden Ansprüche
zur
Steuerung der Helligkeit von Anzeigen.

21. Verwendung eines Strahlungsdetektors nach einem der vorhergehenden Ansprüche

zur

Steuerung des Ein- oder Ausschaltzeitpunkts von Beleuchtungs-

5 einrichtungen.

1/2

FIG 1A

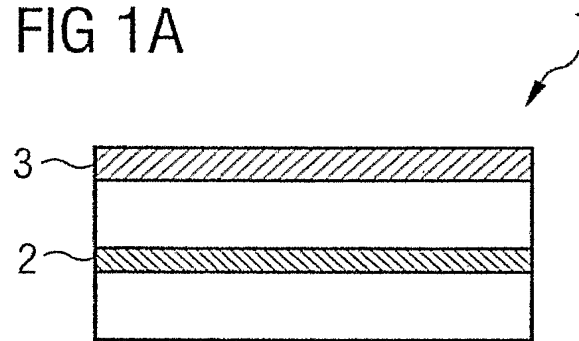
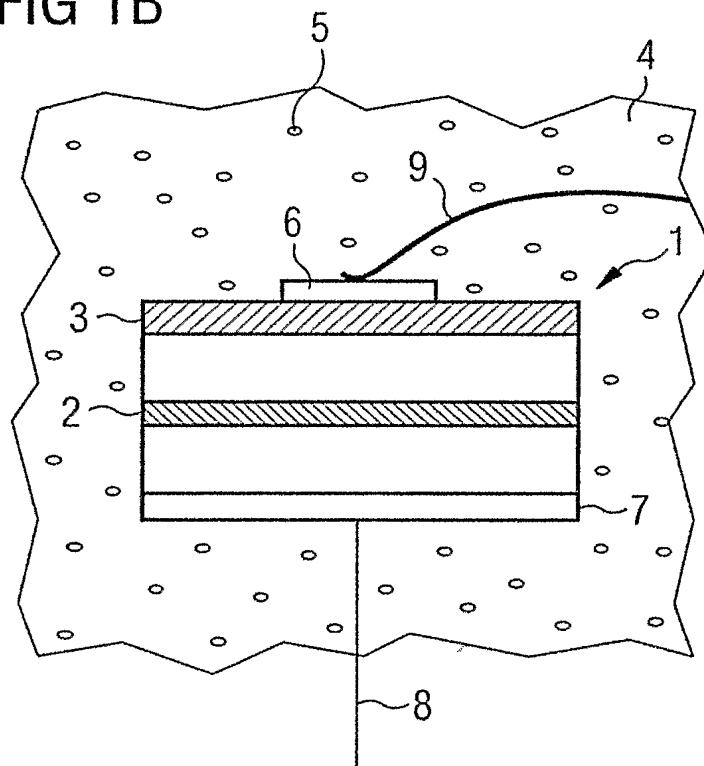
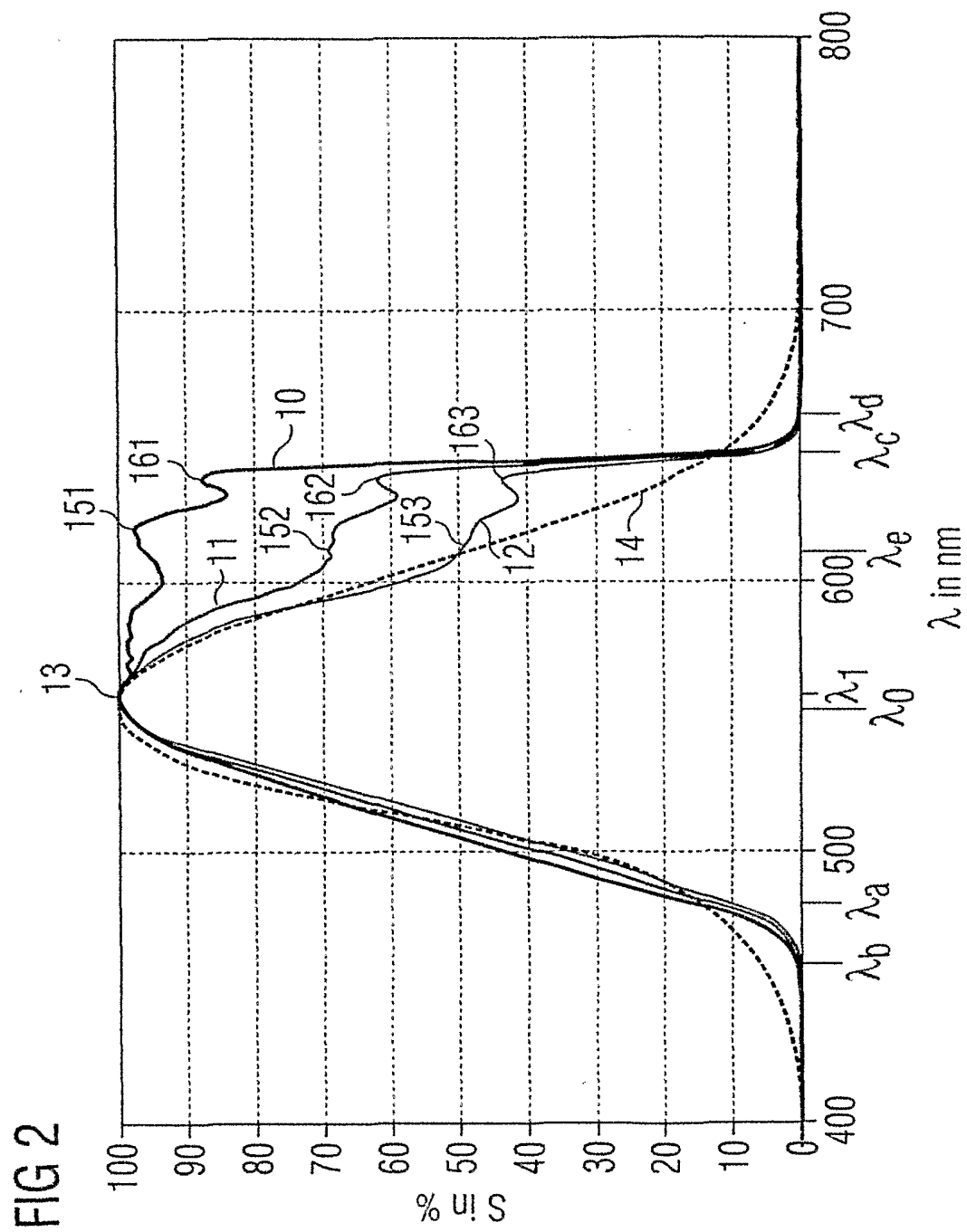


FIG 1B



2/2



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Mai 2005 (06.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/041247 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 31/0203**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001877

(22) Internationales Anmeldedatum:
24. August 2004 (24.08.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10345410.1 30. September 2003 (30.09.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS
GMBH** [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regens-
burg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HAAS, Heinz**
[DE/DE]; Wassergasse 14, 93059 Regensburg (DE).
MÖLLMER, Frank [DE/DE]; Am Mühlgraben 4, 93080
Matting b. Pentling (DE). **SCHWIND, Michael** [DE/DE];
Heckenweg 12, 93161 Sinzing (DE).

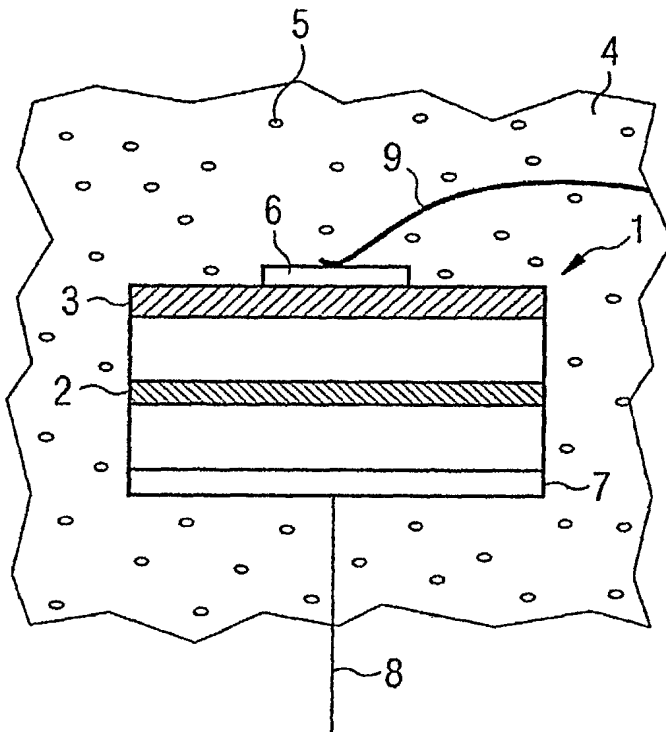
(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATEN-
TANWALTSGESELLSCHAFT MBH**; Ridlerstrasse 55,
80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: RADIATION DETECTOR

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSDETEKTOR



(57) Abstract: The invention relates to a radiation detector for detecting radiation with a preset spectral sensitivity distribution (14), which has a maximum sensitivity in a predetermined wavelength λ_0 , wherein the radiation detector preferably contains a III-V semiconductor material and more preferably comprises at least one semiconductor chip (1) and at least one optical filter arranged downstream of the semiconductor chip. The semiconductor chip contains at least one III-V semiconductor material and the filter absorbs radiation with a wavelength that is bigger than wavelength λ_0 of the maximum sensitivity.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Strahlungsdetektor zur Detektion von Strahlung mit einer vorgegebenen spektralen Empfindlichkeitsverteilung (14), die ein Empfindlichkeitsmaximum bei einer vorgegebenen Wellenlänge λ_0 aufweist wobei der Strahlungsdetektor bevorzugt ein III-V-Halbleitermaterial enthält und besonders bevorzugt mindestens einen Halbleiterchip (1) und mindestens einen dem Halbleiterchip nachgeordneten optischen Filter umfasst, wobei der Halbleiterchip mindestens ein III-V-Halbleitermaterial enthält und der

optische Filter Strahlung mit einer Wellenlänge absorbiert, die größer als die Wellenlänge λ_0 des Empfindlichkeitsmaximums ist.

WO 2005/041247 A3



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

- (88) **Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:**

7. Juli 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE2004/001877

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01L31/0203

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 476 374 B1 (KOZLOWSKI LESTER J ET AL) 5 November 2002 (2002-11-05) column 7, line 55 - line 58; figure 2; table 1	1-4, 6-12, 14
X	US 5 600 157 A (ABIKO ET AL) 4 February 1997 (1997-02-04) claim 1; figure 7	3-5, 14, 15
	----- -/-- -----	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 April 2005

Date of mailing of the international search report

06/05/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Roy, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/001877

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KARRER UWE ET AL: "AlGaIn-based ultraviolet light detectors with integrated optical filters" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B: MICROELECTRONICS PROCESSING AND PHENOMENA, AMERICAN VACUUM SOCIETY, NEW YORK, NY, US, vol. 18, no. 2, March 2000 (2000-03), pages 757-760, XP012008116 ISSN: 0734-211X figures 1,2	1, 11-13
X	----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 09, 3 September 2003 (2003-09-03) -& JP 2003 150089 A (MASPRO DENKOH CORP), 21 May 2003 (2003-05-21) abstract	3, 16-21
X	----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 03, 3 April 2002 (2002-04-03) -& JP 2001 308351 A (TOSHIBA CORP), 2 November 2001 (2001-11-02) abstract	1, 3
A	----- US 3 903 413 A (MANNING ET AL) 2 September 1975 (1975-09-02) claim 1 -----	1, 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001877

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6476374	B1	05-11-2002	US 6483116 B1	19-11-2002
US 5600157	A	04-02-1997	JP 6314819 A	08-11-1994
			JP 3187213 B2	11-07-2001
			JP 7066454 A	10-03-1995
			JP 7106536 A	21-04-1995
JP 2003150089	A	21-05-2003	NONE	
JP 2001308351	A	02-11-2001	NONE	
US 3903413	A	02-09-1975	CA 1063400 A1	02-10-1979
			DE 2457572 A1	12-06-1975
			FR 2254036 A1	04-07-1975
			GB 1482794 A	17-08-1977
			JP 1286214 C	31-10-1985
			JP 50091339 A	22-07-1975
			JP 60005921 B	14-02-1985

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01L31/0203

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 476 374 B1 (KOZLOWSKI LESTER J ET AL) 5. November 2002 (2002-11-05) Spalte 7, Zeile 55 - Zeile 58; Abbildung 2; Tabelle 1	1-4, 6-12, 14
X	US 5 600 157 A (ABIKO ET AL) 4. Februar 1997 (1997-02-04) Anspruch 1; Abbildung 7 ----- -/--	3-5, 14, 15

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. April 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/05/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Roy, C

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	KARRER UWE ET AL: "AlGaIn-based ultraviolet light detectors with integrated optical filters" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B: MICROELECTRONICS PROCESSING AND PHENOMENA, AMERICAN VACUUM SOCIETY, NEW YORK, NY, US, Bd. 18, Nr. 2, März 2000 (2000-03), Seiten 757-760, XP012008116 ISSN: 0734-211X Abbildungen 1,2	1,11-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2003, Nr. 09, 3. September 2003 (2003-09-03) -& JP 2003 150089 A (MASPRO DENKOH CORP), 21. Mai 2003 (2003-05-21) Zusammenfassung	3,16-21
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2002, Nr. 03, 3. April 2002 (2002-04-03) -& JP 2001 308351 A (TOSHIBA CORP), 2. November 2001 (2001-11-02) Zusammenfassung	1,3
A	US 3 903 413 A (MANNING ET AL) 2. September 1975 (1975-09-02) Anspruch 1	1,3

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001877

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6476374	B1	05-11-2002	US	6483116 B1	19-11-2002
US 5600157	A	04-02-1997	JP	6314819 A	08-11-1994
			JP	3187213 B2	11-07-2001
			JP	7066454 A	10-03-1995
			JP	7106536 A	21-04-1995
JP 2003150089	A	21-05-2003	KEINE		
JP 2001308351	A	02-11-2001	KEINE		
US 3903413	A	02-09-1975	CA	1063400 A1	02-10-1979
			DE	2457572 A1	12-06-1975
			FR	2254036 A1	04-07-1975
			GB	1482794 A	17-08-1977
			JP	1286214 C	31-10-1985
			JP	50091339 A	22-07-1975
			JP	60005921 B	14-02-1985